

Title (en)  
Cathode arrangement for GTO thyristor

Title (de)  
Kathodenanordnung für GTO-Thyristor

Title (fr)  
Arrangement de cathode pour thyristor de type GTO

Publication  
**EP 0833390 A2 19980401 (DE)**

Application  
**EP 97116741 A 19970925**

Priority  
DE 19640242 A 19960930

Abstract (en)  
A cathode arrangement for a GTO thyristor has a planar emitter zone (2) embedded in a base layer (1), a gate electrode (4) contacting the base layer (1), a metal emitter electrode (13) provided on the emitter zone (2), and a metal pressure plate (7) pressed on the emitter electrode surface which is at least 10-15 microns above the emitter zone surface so that the underside of the pressure plate (7) is spaced from the top of the gate electrode (4). The novelty comprises one of the following: (a) the emitter electrode (13) covers an insulating layer (8) applied on the emitter zone (2) such that it contacts the emitter zone (2) at the edge of the insulating layer (8); (b) a resistive layer, provided between the emitter zone and the emitter electrode, extends laterally from the middle of the emitter zone surface over an insulating film to the emitter zone edge where it contacts the emitter electrode; or (c) the emitter electrode comprises an electroplated metal layer.

Abstract (de)  
Die Erfindung betrifft eine Kathodenanordnung für GTO-Thyristoren mit einer in eine Basisschicht (1) planar eingebrachten Emitterzone (2), auf der sich eine höckerartige Emittierelektrode (13;3,14) befindet, deren Höhe entweder durch Unterfütterung mit einer Isolatorschicht (8) oder durch eine Galvanikschicht (14) ausreichend groß eingestellt ist, damit sich eine Druckplatte (7) in ausreichendem Abstand von Gate-Elektroden (4) befindet. Zwischen der Emittierelektrode (13;3,14) und der Emitterzone (2) kann gegebenenfalls noch eine laterale Widerstandsschicht (11) aus polykristallinem Silizium vorgesehen werden. <IMAGE>

IPC 1-7  
**H01L 29/744**; **H01L 29/417**

IPC 8 full level  
**H01L 29/74** (2006.01); **H01L 29/744** (2006.01)

CPC (source: EP)  
**H01L 29/744** (2013.01)

Cited by  
US6555849B1; WO9959209A1

Designated contracting state (EPC)  
CH DE FR GB IT LI

DOCDB simple family (publication)  
**EP 0833390 A2 19980401**; **EP 0833390 A3 19990929**; **EP 0833390 B1 20070307**; DE 19640242 A1 19980402; DE 19640242 C2 20020110; DE 59712822 D1 20070419; JP 3665453 B2 20050629; JP H10112540 A 19980428

DOCDB simple family (application)  
**EP 97116741 A 19970925**; DE 19640242 A 19960930; DE 59712822 T 19970925; JP 28132997 A 19970929